

HÍRADÁS

1989. március 13-15 között Baden-Badenben a nyugatnémet Mikroelektronikai Társaság konferenciát tartott. A rendezvény résztvevői és előadói a nyugatnémet félvezető ipar legjobb szakemberei (kutatók, konstruktőrök, technológusok) és a különböző felsőoktatási intézmények professzorai, akik félvezető konstrukcióval és technológia-kutatással foglalkoznak. Ezen okok miatt nagy jelentőségű a magyar egyesületek (HTE, MEE) kapcsolata a nyugatnémet egyesülettel (VDE), amely a baden-hadeni konferenciák szervezője.

A konferencián elhangzottak iparpolitikai, technológia politika és a piacutatósi problémákkal foglalkozó előadások is, de a rendezvény fő témája a mikroelektronika egy speciális területe a félvezető technológia.

Az előadások döntő többsége félvezető tárgyú volt. Különböző konstrukciós és kapcsolástechnikai eredmények kerültek ismertetésre speciális alkalmazási célokra. Jelentős teret kapott az új műveletek bemutatása megfelelő felhasználási területek-

kel kiegészítve: legfontosabb közülük a SOI- technika bemutatása volt. A szilíciumot a szigetelő szerkezetben (SOI) implantációval lézeres átkristályosítással, vagy molekuláris epitaxiával alakítják ki.

A memóriák közül SRAM-ok előállítására a Philipsnél gyártási szinten $0,7 \mu\text{m}$ vonalszélességgel folyik (1 Mb SRAM), míg a fejlesztési részleg $0,5 \mu\text{m}$ vonalszélességet alkalmaz a 4 Mb SRAM-ok megvalósításához. Elektronsugaras litográfiát alkalmaznak néhány felhasználói kapuáramkör gyors befejezésére.

A bipoláris áramkörök elemsűrűségének növelésére az implantált, illetve a polikristályokból kialakított emitter- bázis struktúrákat, valamint az oxidszigetelést alkalmazzák. Intenzív kutatás kezdődött különböző mikroelektronikai alkatrészek háromdimenziós célintegrálására.

dr. Tímár József (MEV)
Pruzsina Ferenc (REMIX)